



中华人民共和国国家标准

GB/T 41325—2022

集成电路用低密度晶体原生凹坑 硅单晶抛光片

Low density crystal originated pit polished monocrystalline silicon wafers for
integrated circuit

2022-03-09 发布

2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2)共同提出并归口。

本文件起草单位：有研半导体硅材料股份公司、山东有研半导体材料有限公司、杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、南京国盛电子有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、中环领先半导体材料有限公司、浙江海纳半导体有限公司。

本文件主要起草人：孙燕、宁永铎、钟耕杭、李洋、徐新华、骆红、杨素心、李素青、张海英、由佰玲、潘金平。